

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины – формирование у обучающихся знаний и навыков в области создания, функциональных свойств и применения новых классов наноструктур и наноструктурированных материалов, проявляющих новые физические свойства.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Формирование у обучающихся знаний о физическо-химических явлениях, происходящих в материалах на наноуровне и изучение влияния размерного фактора на свойства (термодинамические, кристаллохимические, электронные, оптические, магнитные, механические) наноструктурированных систем; ознакомление с имеющимися и потенциальными возможностями практического применения наноструктурированных материалов при создании устройств для микроэлектроники и последними достижениями в данной области; формирование навыков получения наноструктурированных материалов и их применения при разработке компонентов микросистемной техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Перспективные наноструктурные материалы» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Перспективные наноструктурные материалы» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-5 - Способен учитывать и прогнозировать влияние размерного фактора на параметры наногетероструктурных объектов и изделий.

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-5	знать физическо-химические явления, происходящие в материалах на наноуровне; влияние структурного состояния на свойства наноразмерных или тонкопленочных материалов
	уметь разрабатывать наноразмерные и тонкопленочные материалы и структуры со свойствами качественно и количественно отличными от свойств объемных материалов
	владеть методами разработки и получения тонкопленочных и наноразмерных структур с заданными структурными параметрами

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Перспективные наноструктурные материалы» составляет 5 з.е.

**Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	72	72
В том числе:		
Лекции	36	36
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Лабораторные работы (ЛР)	18	18
Самостоятельная работа	63	63
Часы на контроль	45	45
Виды промежуточной аттестации - экзамен	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	180	180
зач.ед.	5	5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	Лаб. зан.	СРС
1	Введение	Структура и объекты исследования предмета перспективные наноструктурные материалы. Определение наночастицы. Размернозависимые физико-химические свойства материалов. Классификация размерных эффектов: внутренние и внешние, классические и квантовые. Роль геометрической формы поверхности наноструктур. Классификация наноструктур по размерности и топологическим признакам. Проблема устойчивости наноматериалов.	2	0	0	3
2	Углеродные наноструктуры: фуллерен	Фуллерен и его производные. Структура фуллеренов и фуллеритов. Методы получения и разделения фуллеренов. Применение фуллеренов. Фуллерены как полупроводниковые и наноконструкционные материалы. Фуллерены как материалы для нелинейной оптики. Свойства легированного фуллерита. Фуллерены как прекурсоры для роста алмазных пленок и пленок карбида кремния. Фуллерены как материал для литографии. Использование фуллеренов в медицине: в качестве основы лекарственных препаратов; для расщепления ДНК. Сверхтвердые фуллериты.	4	2	0	6
3	Углеродные наноструктуры: графен и наноалмазы	Графен и наноалмазы. Графен как перспективный материал для нанoeлектронных устройств. Электронные свойства графена.	6	2	6	8

		<p>Поведение электронов проводимости в графене. Электроны и дырки в графене. Подвижность носителей заряда в графене. Модификации графена: наноленты и двухслойный графен. Приборы на основе графена: современное состояние. Наноалмазы. Детонационный синтез наноалмазов и извлечение наноалмазов из продуктов взрыва. Традиционные способы применения наноалмазов: абразивные покрытия, компоненты износостойких присадок и покрытий. Перспективные области использования наноалмазов: в биологии, биохимии и медицине.</p>				
4	Углеродные наноструктуры: нанотрубки и нановолокна	<p>Углеродные нанотрубки и нановолокна. Структура углеродных нанотрубок, хиральность. Дефекты структуры углеродных нанотрубок. Методы получения нанотрубок. Дуговой синтез. Лазерный синтез. Пиролиз углеводородов. Очистка и раскрытие нанотрубок: химические способы, физические способы. Электрические и механические свойства нанотрубок. Применение углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки как зонды АСМ. Углеродные нанотрубки как соединительные проводники. Полевая эмиссия и экранирование. Переключающие устройства из углеродных нанотрубок для компьютера. Химические сенсоры на основе углеродных нанотрубок. Полевой транзистор, нанодиод на основе однослойной углеродной нанотрубки. Углеродная «наноткань». Механическое упрочнение композитов. Возможности применения углеродных нанотрубок в создании наноразмерных механических устройств и наноактуаторов; в качестве нанопористых фильтрующих элементов, зондов для сканирующих микроскопов.</p>	6	4	0	12
5	Нанокристаллические материалы	<p>Нанопленки. Кинетика, термодинамика, механизмы роста пленок. Критерии ориентированной кристаллизации. Атомная структура и субструктура межфазных границ. Методы получения тонких пленок. Природа и механизм образования дефектов кристаллической структуры пленок.</p> <p>Полупроводниковые нанопленки. Магнитные нанопленки. Многослойные пленочные наноструктуры. Алмазоподобные и керамические нанопленки. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. Биоактивные наноструктурированные покрытия</p> <p>Нанопроволоки. Методы получения. Возможное практическое применение.</p> <p>Объемные нанокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией (Схемы ИПД). Структурообразование в процессе ИПД. Свойства материалов в результате ИПД. Объемные нанокристаллические материалы, полученные компактированием нанопорошков.</p> <p>Термическая устойчивость материалов с нанодисперсной структурой. Нанокристаллические материалы, полученные кристаллизацией аморфных.</p>	6	4	8	12
6	Фотонные кристаллы	<p>Конструктивная интерференция. Запрещенные зоны и дисперсионные кривые. Дисперсионные диаграммы. Дефекты фотонных кристаллов. Преломление и отражение света в фотонном кристалле. Левые</p>	8	4	0	12

		среды. Метаматериалы. Фотонные волокна. Микрорезонаторы на основе фотонных кристаллов. Изготовление фотонных кристаллов. Магнитные фотонные кристаллы.				
7	Нанокomпозиты	Металлические композиты, армированные наночастицами. Полимерные композиты, армированные наночастицами. Стекланные композиты, армированные наночастицами. Магнитные и радиопоглощающие металлсодержащие наноматериалы. Простые (монометаллические) наночастицы. Наночастицы со структурой ядро-оболочка. Ферритовые наночастицы. Материалы с комбинированными наполнителями. Наночастицы на ультрадисперсных носителях. Поглотители электромагнитных волн на основе нанокomпозитов.	4	2	4	10
	Контроль					
Итого			36	18	18	63

5.2 Перечень лабораторных работ

Укажите перечень лабораторных работ

1. Синтез нанокристаллических биосовместимых и сегнетоэлектрических покрытий методами вакуумного распыления
2. Синтез нанокристаллических эпитаксиальных пленок карбида кремния на кремнии методом фотонной обработки
3. Исследование поверхности наноструктур методом атомно-силовой микроскопии
4. Синтез нанопористых структур методом анодного оксидирования металла

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-5	знать физическо-химические явления, происходящие в материалах на наноуровне; влияние структурного состояния на свойства наноразмерных или тонкопленочных	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	материалов			
	уметь разрабатывать наноразмерные и тонкопленочные материалы и структуры со свойствами качественно и количественно отличными от свойств объемных материалов	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть методами разработки и получения тонкопленочных и наноразмерных структур с заданными структурными параметрами	Решение прикладных задач в конкретной предметной области; проведение анализа данных, полученных по результатам диагностики физических и структурных параметров наносистем	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
ПК-5	знать физико-химические явления, происходящие в материалах на наноуровне; влияние структурного состояния на свойства наноразмерных или тонкопленочных материалов	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
	уметь разрабатывать наноразмерные и тонкопленочные материалы и структуры со свойствами качественно и количественно отличными от свойств объемных материалов	Решение стандартных практических задач	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	владеть методами разработки и получения тонкопленочных и наноразмерных структур с заданными структурными параметрами	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типичные контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Сопоставьте термин и его определение

(Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа):

- 1) наночастица
- 2) квантовая точка
- 3) кластер
- 4) нанотрубка
- 5) фуллерен

а. компактная обособленная группа связанных друг с другом атомов, молекул или ионов, которая обладает свойствами, в той или иной степени отличными от свойств составляющих ее элементов.

б. аллотропная модификация углерода, часто называемая молекулярной формой углерода, включает целый ряд атомных кластеров C_n ($n > 20$), представляющих собой построенные из атомов углерода замкнутые выпуклые многогранники с пяти- и шестиугольными гранями

в. изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трех измерениях составляют от 1 до 100 нм.

г. частица материала с размером, близким к длине волны электрона в этом материале (обычно размером 1-10 нм), внутри которой потенциальная энергия электрона ниже, чем за его пределами, таким образом, движение электрона ограничено во всех трех измерениях.

д. полая цилиндрическая структура диаметром от десятых до нескольких десятков нм и длиной от одного до нескольких сотен микрометров и более, образованная атомами углерода и представляющая собой свернутую в цилиндр графеновую плоскость.

2. Что такое фуллерен?

(Выберите один из 4 вариантов ответа):

- 1) Перколированный графит
- 2) Углеродная нанотрубка
- 3) Семейство шарообразных полых молекул общей формулы C_n
- 4) Плоский лист графита мономолекулярной толщины

3. Эндофуллерены – это:

(Выберите один из 4 вариантов ответа)

- 1) эндодральные комплексы, содержащие неуглеродный атом внутри фуллерена
- 2) эндодральные комплексы, содержащие неуглеродный атом снаружи фуллерена
- 3) ионизованные фуллерены
- 4) фуллереновые кластеры

4. Что такое углеродные нанотрубки?

(Выберите один из 3 вариантов ответа):

1) Протяженные структуры, состоящие из свернутых гексагональных сеток с атомами углерода в узлах

- 2) Семейство шарообразных полых молекул общей формулой C_n
- 3) Протяженные структуры из углеродных переплетённых цепей

5. Все однослойные углеродные нанотрубки обладают следующими свойствами:

(выберите одно некорректное утверждение)

- 1) высокой прочностью
- 2) высокой упругостью
- 3) высокой электропроводностью

- 4) высокой теплопроводностью
- 5) высокой химической стойкостью

6. Какие материалы можно получить при детонационном синтезе с использованием углеродосодержащей атмосферы?

(Выберите один из 4 вариантов ответа):

- 1) углеродные нанотрубки или нитевидные кристаллиты
- 2) смесь графита с металлом или наноалмазы
- 3) соли или комплексы металлов
- 4) низкотемпературные или высокотемпературные метастабильные кристаллические модификации

7. Фотонные кристаллы состоят из

- 1) только кристаллических материалов.
- 2) материалов, хотя бы один из которых должен быть кристаллическим
- 3) материалов, кристалличность которых не обязательна

8. Трехмерным фотонным кристаллом будет являться материал с показателем преломления, отличным от единицы, внутри которого расположена система упорядоченных:

- 1) вакансий
- 2) квантовых точек
- 3) пор диаметром 0,5 мкм

9. Химическая формула опала:

- 1) TiO_2
- 2) Al_2O_3
- 3) SiO_2

10. С чем связана сложность создания полевого транзистора на основе однослойного графена?

(выберите один из трех вариантов ответов):

- 1) высокая подвижность носителей заряда
- 2) амбиполяриность проводимости
- 3) высокая вероятность образования заряженных дефектов на поверхности графена

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

1. Попадает ли электромагнитное поле световой волны внутрь фотонных кристаллов в случае конструктивной интерференции

- 1) да
- 2) нет
- 3) да только для 1 и 2-х мерных фотонных кристаллов

2. Конструктивная интерференция в многослойных материалах с высоким оптическим контрастом может наблюдаться в случае (выберите один вариант ответа):

- 1) наклонного падения света, когда отраженные от границ между слоями волны равных амплитуд находятся в противофазе
- 2) наклонного падения света, когда отраженные от границ между слоями волны равных амплитуд находятся в фазе
- 3) нормального падения света, когда отраженные от границ между слоями волны равных амплитуд находятся в противофазе

3. Сопоставьте материал и присущие ему свойства:

(Укажите соответствие для вариантов ответа)

- 1) Алмаз
- 2) Графит
- а. Проводник
- б. Изолятор
- в. Максимальная твердость
- г. Максимальная теплопроводность

4. Для какого типа нанотрубок характерен только металлический тип проводимости
(Выберите один из 3 вариантов ответа)

- 1) ахиральные типа «кресло»
- 2) ахиральные типа «зигзаг»
- 3) хиральные

5. Как называется слой атомов углерода, соединённых посредством sp^2 связей в гексагональную двумерную кристаллическую решётку?

(Выберите один из 4 вариантов ответа):

- 1) фуллерен
- 2) графен
- 3) углеродная нанотрубка
- 4) карбин

6. На основе какой углеродной нанотрубки возможно создание выпрямляющего нанодиода?

(выберите один из 3 вариантов ответа):

- 1) Многослойная углеродная нанотрубка
- 2) Заполненная однослойная углеродная нанотрубка
- 3) Однослойная углеродная нанотрубка с дефектом «локтевое соединение» между кресельной и зигзагообразной частями

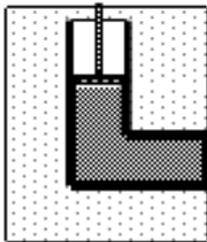
7. Попадает ли электромагнитное поле световой волны внутрь фотонных кристаллов в случае конструктивной интерференции

- 1) да
- 2) нет
- 3) да только для 1 и 2-х мерных фотонных кристаллов

8. При увеличении угла падения по отношению к нормали к одномерному фотонному кристаллу запрещенная зона

- 1) сместится в область больших длин волн
- 2) сместится в область малых длин волн
- 3) не сместится

9. Какой метод получения наноструктурированного материала схематически изображен на рисунке?



- 1) кручение под высоким давлением

- 2) равноканальное угловое прессование
- 3) всесторонняя ковка
- 4) специальная прокатка

10. В узлах кристаллической решетки фуллеритов находятся:

(Выберите один из 3 вариантов ответа)

- 1) атомы углерода
- 2) фуллерены
- 3) наночастицы

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Удельная поверхность открытых одностенных углеродных нанотрубок равна $1000 \text{ м}^2/\text{г}$, а плотность составляет $1.3 \text{ г}/\text{см}^3$. Считая, что у всего материала отношение объема к поверхности – такое же, как и у одной трубки, оцените диаметр нанотрубки.

2. Найдите расстояние между центрами соседних молекул фуллерена в его низкотемпературной модификации (плотность $1.7 \text{ г}/\text{см}^3$), которая имеет примитивную кубическую решетку, где молекулы находятся только в вершинах кубической элементарной ячейки.

3. Рассчитайте массу графенового квадрата размером $10 \times 10 \text{ мм}$. Длина связи С–С в графите равна $0,142 \text{ нм}$.

4. Для насыщения свободных валентностей углерод в графене способен образовывать связи с газообразными веществами. Чему равно максимальное число атомов водорода, которые может присоединить указанный выше графеновый квадрат?

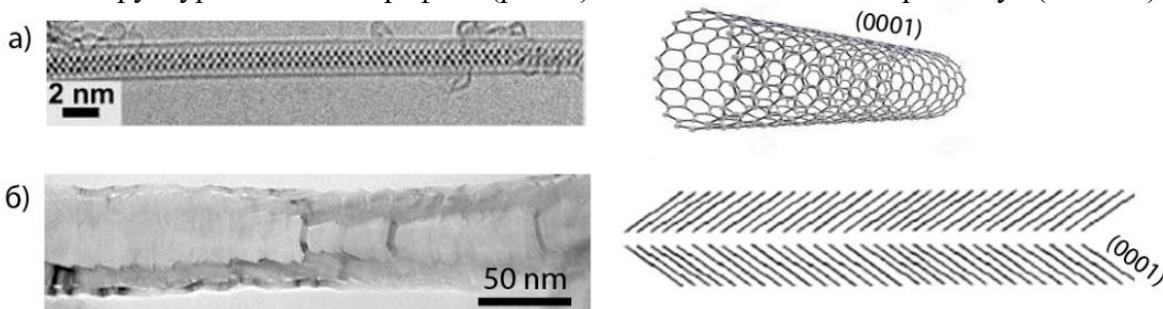
5. Оксид цинка, выращенный в виде цилиндрических наностержней диаметром $20\text{--}150 \text{ нм}$, способен выступать в роли миниатюрного полупроводникового источника лазерного излучения. Форма и размеры нанокристаллов оксида цинка зависят от скорости испарения вещества и положения подложки – основы, на которой происходит рост кристаллов. Добиться параллельного расположения наностержней оксида цинка удастся, используя метод газофазного химического транспорта паров оксида цинка на подложку из нитрида галлия, покрытую тонким слоем золота. Оксид цинка – очень тугоплавкий ($t_{\text{пл}} \sim 2000^\circ \text{С}$) материал. Как можно получить пары этого вещества? Предложите два способа.

6. Углеродные нанотрубки были получены в 1991 году испарением графита в электрической дуге с последующим водяным охлаждением. Другой способ получения углеродных нанотрубок – высокотемпературное разложение бензола. В каком случае речь идет о физическом, а в каком – о химическом осаждении из газовой фазы?

7. Предложите экспериментальные методы определения прочности и модуля Юнга для

нанотрубок.

8. Удельная прочность (получена в испытаниях на растяжение) однослойных углеродных нанотрубок (рис. а), составляет 300-1500 ГПа, удельная прочность углеродных волокон с «ёлочной» структурой пластин графита (рис. б) – 2-4 ГПа. Объясните разницу? (2 балла)



9. На химически инертную подложку вакуумным распылением одновременно осаждают однокомпонентные материалы А и В. Исходя из различных вариантов фазовых диаграмм для данной системы, укажите, в каком случае возможно получение нанокompозита из этих материалов.

10. В каком случае **не** будет наблюдаться конструктивная интерференция для 1-мерного фотонного кристалла (10 слоев) при нормальном падении света при условии

а	б	в
$d_1 = 0,05;$	$0,17;$	$0,05$
$d_2 = 1,125;$	$0,15;$	$0,4$
$n_1 = 2,5;$	$2,2;$	$2,0$
$n_2 = 1;$	$1,5;$	$1,25$
$\lambda = 0,5$	$0,3$	$0,4$

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Не предусмотрено учебным планом

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Классификация наноструктур по размерности и топологическим признакам.
2. Фуллерен и его производные. Структура фуллеренов и фуллеритов.
3. Методы получения и разделения фуллеренов. Применение фуллеренов.
4. Углеродные нанотрубки и нановолокна. Структура углеродных нанотрубок, хиральность. Дефекты структуры углеродных нанотрубок.
5. Методы получения нанотрубок. Дуговой синтез. Лазерный синтез. Пиролиз углеводородов.
6. Применение углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки как зонды АСМ. Углеродные нанотрубки как соединительные проводники. Полевая эмиссия и экранирование. Полевой транзистор, нанодиод на основе однослойной углеродной нанотрубки.
5. Графен. Электронные свойства графена. Поведение электронов проводимости в графене. Подвижность носителей заряда в графене.
6. Наноалмазы. Детонационный синтез наноалмазов и извлечение наноалмазов из продуктов взрыва. Применение наноалмазов.
7. Нано пленки. Кинетика, термодинамика, механизмы роста пленок. Полупроводниковые нано пленки. Магнитные нано пленки. Многослойные пленочные наноструктуры. Алмазоподобные и керамические нано пленки. Биоактивные наноструктурированные покрытия
8. Нанопористые материалы. Получение и свойства нанопористого кремния. Получение и свойства нанопористого оксид алюминия.

9. Объемные нанокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. Структурообразование в процессе ИПД. Свойства материалов в результате ИПД. Термическая устойчивость материалов с нанодисперсной структурой.

10. Фотонные кристаллы. Принципы структурной организации материалов с оптической зонной структурой. Конструктивная интерференция. Типы фотонных кристаллов.

11. Фотонные кристаллы. Запрещенные зоны и дисперсионные кривые. Дисперсионные диаграммы. Дефекты фотонных кристаллов.

12. Фотонные кристаллы. Левые среды. Метаматериалы. Фотонные волокна. Микрорезонаторы на основе фотонных кристаллов.

13. Основы методов получения аэрогелей. Сверхкритическая сушка. Сушка при атмосферном давлении. Типы аэрогелей. Неорганические аэрогели. Применение аэрогелей.

14. Нанокompозиты. Металлические композиты, армированные наночастицами. Полимерные композиты, армированные наночастицами. Стекланные композиты, армированные наночастицами.

15. Нанокompозиты. Магнитные и радиопоглощающие металлсодержащие наноматериалы. Простые (монометаллические) наночастицы. Наночастицы со структурой ядро-оболочка. Ферритовые наночастицы. Материалы с комбинированными наполнителями. Наночастицы на ультрадисперсных носителях. Поглотители электромагнитных волн на основе нанокompозитов.

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 15 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 5 баллов (3 балла верное решение и 2 балла за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 6 баллов.

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 10 баллов

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 баллов.

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Введение	ПК-5	Защита реферата
2	Углеродные наноструктуры: фуллерен	ПК-5	Тест, контрольная работа
3	Углеродные наноструктуры: графен и нанодиамазы	ПК-5	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ
4	Углеродные наноструктуры: нанотрубки и нановолокна	ПК-5	Тест, контрольная работа
5	Нанокристаллические материалы	ПК-5	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ
6	Фотонные кристаллы	ПК-5	Тест, контрольная работа
7	Нанокompозиты	ПК-5	Тест, контрольная работа, защита

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие	Годы издания. Вид издания	Обеспеченность
7.1.1. Основная литература				
7.1.1.1	Гусев, А.И.	Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии	2009 печатн.	0,6
7.1.1.2	И. В. Золотухин, О. В. Стогней	Физика наносистем: графены и гранулированные нанокompозиты : Учеб. пособие	2011 печатн.	0,9
7.1.1.3	В. М. Иевлев, А. В. Бугаков, В. И. Трофимов	Рост и субструктура конденсированных пленок: учебн. пособие	2000 печатн.	0,6
7.1.2. Дополнительная литература				
7.1.2.1	И.П. Суздалев	Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов	2006 печатн.	0,2
7.1.2.2	Головин, Ю.И.	Наномир без формул	2012 печатн.	0,4
7.1.2.3	С. А. Гриднев	Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах	2012 печатн.	0,4

7.1.2.4	Д. М. Мартинес-Дуарт, Р. Д. Мартин-Палма,	Нанотехнологии для микро- и наноэлектроники	2009 печатн.	0,2
7.1.2.5	Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля	Наноструктурные материалы : учеб. пособие	2005 печатн.	0,2
7.1.3 Методические разработки				
7.1.3.1	А.В. Костюченко	Методические указания к лабораторным работам № 1-4 по курсу "Перспективные наноструктурированные материалы" для студентов направления 222900.62 "Компоненты микро- и наносистемной техники» (бакалавры) очной формы обучения	2015 электр.	1,0

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Укажите перечень информационных технологий

8.2.1 Компьютерные практические работы:

- Обработка результатов сканирующей туннельной микроскопии с использованием программы «Image_Analysis_P9»

Работа с базой межплоскостных расстояний «Powder Diffraction File Alphabetical Index Inorganic Compounds»

8.2.2 Мультимедийные видеофрагменты:

- Лекции с сайта <http://www.nanometer.ru>

8.2.3 Мультимедийные лекционные демонстрации:

- Презентации по курсу перспективные наноструктурные материалы

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Укажите материально-техническую базу

9.1 Специализированная лекционная аудитория, оснащенная оборудованием для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой

9.2 Учебные лаборатории:

Просвечивающей электронной микроскопии и электронографии

9.3 Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами

9.4 Натурные лекционные демонстрации:

- Напылительные вакуумные установки ВУП-5, УВН-74М
- Установка фотонного отжига УОЛП-1М
- Сканирующий зондовый микроскоп Solver47
- Углеродные нанотрубки, нанопористые оксидные покрытия, биосовместимые нанокристаллические покрытия

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Перспективные наноструктурные материалы» читаются

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета режимов синтеза и контроля структуры наноструктурированных материалов. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Лабораторная работа	Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомиться с соответствующим разделом учебника, проработать дополнительную литературу и источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: <ul style="list-style-type: none">- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций;- выполнение домашних заданий и расчетов;- работа над темами для самостоятельного изучения;- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.